# 06.1;06.5

# Морфология и оптические свойства композитного материала на основе наночастиц золота и нестехиометрического оксида кремния

© А.О. Замчий<sup>1,2</sup>, С.В. Старинский<sup>1,2</sup>, Е.А. Баранов<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия <sup>2</sup> Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия E-mail: zamchiy@gmail.com

Поступило в Редакцию 8 мая 2020 г. В окончательной редакции 19 мая 2020 г. Принято к публикации 19 мая 2020 г.

Впервые проведено исследование морфологии, структурных и оптических свойств композитного материала на основе наночастиц золота и тонкой пленки аморфного нестехиометрического оксида кремния (a-SiO<sub>x</sub>, x = 1.8). На основе полученных результатов экспериментально показано, что слой a-SiO<sub>1.8</sub> конформно покрывает наночастицы сферической формы. Аналитическая модель на базе теории Ми хорошо описывает полученные из эксперимента оптические свойства наночастиці золота и композитного материала в ультрафиолетовой области спектра, а также изменение амплитуды плазмонного пика при формировании композитного материала.

Ключевые слова: наночастицы золота, тонкие пленки, нестехиометрический оксид кремния, локализованный плазмонный резонанс, просвечивающая электронная микроскопия.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.16.49855.18372

Наночастицы (НЧ) благородных металлов (золота, серебра и др.) проявляют выраженные плазмонные свойства в видимом диапазоне длин волн [1]. Зачастую практическое использование плазмонных НЧ предполагает их внедрение в диэлектрическую или полупроводниковую матрицу с функциональными и/или защитными свойствами [2,3]. Получаемые композитные материалы находят широкое применение при создании химических и биологических сенсоров [4], солнечных элементов [5], бактерицидных и противовирусных покрытий [6]. Наличие матрицы препятствует влиянию окружающей атмосферы на НЧ и предотвращает их деградацию, что способствует сохранению уникальных оптических свойств материала [3]. В то же время оптические свойства окружающей НЧ матрицы, а также общая морфология композитного материала оказывают существенное влияние на резонансную частоту локализованных плазмонов [2,3,7]. Следует отметить, что при получении композитного материала могут реализоваться необратимые процессы, приводящие к ухудшению и даже исчезновению его плазмонных свойств, диффузия НЧ из матрицы на ее поверхность, их агломерация, а также формирование соединений элементов материала матрицы и НЧ, вызванные, в частности, высокими температурами синтеза [7,8].

Помимо эмпирических подходов по оптимизации процесса синтеза композитных материалов интерес исследователей также сфокусирован на усовершенствовании методов расчета для таких систем. Сегодня имеется множество аналитических [9] и расчетных работ [10], описывающих рассеяние падающего излучения на наномет-

ровых объектах. Однако зачастую для полноценной верификации разрабатываемой теоретической модели получаемый объем экспериментальных данных о характеристиках изучаемого материала бывает недостаточным. В настоящей работе с помощью взаимодополняющих методик проведено исследование морфологии, структурных и оптических свойств композитного материала, представляющего собой НЧ Аи в матрице аморфного нестехиометрического оксида кремния  $(a-\text{SiO}_x)$ . Отметим, что a-SiO<sub>x</sub>, с одной стороны, широко используется в полупроводниковой промышленности [11], а с другой стороны, является подходящим материалом для исследования влияния матрицы на свойства плазмонных НЧ. На основании полученных результатов сделаны выводы о различии между экспериментальными и расчетными плазмонными свойствами композитного материала.

НЧ Аи были получены методом импульсной лазерной абляции с использованием второй гармоники наносекундного Nd:YAG-лазера (длина волны 532 nm, период 9 ns) на подложках из кварца и монокристаллического кремния (*c*-Si). Осаждение металла осуществлялось в атмосфере аргона при давлении 60 Pa и температуре подложки 500°C. Далее HЧ Au покрывались тонкой пленкой *a*-SiO<sub>x</sub> (~ 35 nm) методом плазмохимического осаждения из газовой фазы из смеси моносилана и кислорода. Мощность высокочастотного (13.56 MHz) излучения и температура подложки в процессе синтеза составляли 50 W и 220°C соответственно.

На рис. 1 представлено изображение островковой пленки Au до осаждения *a*-SiO<sub>x</sub>, полученное методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на



Рис. 1. СЭМ-изображение НЧ Аи на подложке из *c*-Si.

приборе JEOL JSM-6700F. Распределение частиц по размерам описывается бимодальной функцией. Размер мелкой популяции составляет несколько единиц нанометров, средний диаметр частиц крупной популяции около 12 nm. Наблюдаемая морфология типична для высокотемпературного осаждения пленок золота методом импульсной лазерной абляции в фоновом газе. Бимодальная функция распределения НЧ обусловлена их ростом из двух различных видов зародышей. Первый тип образуется в результате столкновения блуждающих по поверхности осажденных атомов. Роль зародышей второго типа играют малые кластеры, образующиеся на этапе разлета лазерного факела [12].

На рис. 2, а представлены спектры экстинкции НЧ Аи на кварцевой подложке, пленки *a*-SiO<sub>x</sub>, а также композитного материала HЧ Au/a-SiO<sub>x</sub>, полученные с использованием спектрофотометра СФ-2000 ("ЛОМО-Спектр", Санкт-Петербург). Оптические характеристики НЧ Аи определяются крупной популяцией частиц ввиду кубической зависимости сечения рассеяния от диаметра [1]. Положение плазмонного пика НЧ Аu составляет 621 nm и смещено в длинноволновую область спектра по сравнению с положением, полученным из расчета для изолированной сферической НЧ, которое составило 505 nm. По-видимому, этот сдвиг обусловлен взаимополяризацией НЧ, поскольку плотность заполнения поверхности частицами составляет 45% (рис. 1). Таким образом, характерное расстояние между границами частиц крупной популяции составляет ~ 10 nm, что сопоставимо с пространственным масштабом локализованного плазмона. После осаждения тонкой пленки *a*-SiO<sub>x</sub> в спектре происходит смещение положения резонансного пика в длинноволновую область. При этом увеличение экстинкции в ультрафиолетовой (УФ) области спектра главным образом определяется фундаментальным поглощением в a-SiO<sub>x</sub>, т.е. в данной области спектра влияние матрицы на оптические свойства НЧ Аи пренебрежимо мало. Методом спектральной эллипсометрии было установлено, что в видимой области спектра действительная часть показателя преломления *a*-SiO<sub>x</sub> практически неизменна и равна 1.59, при этом его мнимая часть отличается от нуля только в УФ-диапазоне излучения. Расчет показал, что смещение плазмонного пика изолированной НЧ в материале с подобными оптическими свойствами составляет ~ 40 nm, при этом в эксперименте наблюдается заметно меньший сдвиг (~15 nm). Возможным объяснением такого смещения является уменьшение эффекта взаимополяризации НЧ из-за заполнения пространства между ними оптически плотным веществом. Тем не менее расчет хорошо описывает экспериментально полученные оптические свойства как для НЧ Au, так и для композитного материала в УФ-области спектра. При этом наличие слоя *a*-SiO<sub>x</sub> приводит к одинаковому увеличению амплитуды плазмонного пика в экспериментальном и расчетном спектрах.

Сравнение ИК-фурье-спектров a-SiO<sub>x</sub> и композитного материала НЧ Au/a-SiO<sub>x</sub>, полученных с использованием спектрометра Scimitar FTS 2000, показывает отсутствие влияния НЧ на состав и структурную сетку осаждае-



**Рис. 2.** *а* — экспериментальные (сплошные линии) и расчетные (пунктирные линии) спектры экстинкции НЧ Au (*1*, *4*), *a*-SiO<sub>1.8</sub> (*2*), а также композитного материала НЧ Au/*a*-SiO<sub>1.8</sub> (*3*, *5*). *b* — спектральные зависимости оптической плотности *a*-SiO<sub>x</sub> (*1*) и композитного материала НЧ Au/*a*-SiO<sub>x</sub> (*2*) в инфракрасном диапазоне.



Рис. 3. а — ПЭМ-изображение композитного материала НЧ Au/a-SiO<sub>1.8</sub>. На вставке показано ВРПЭМ-изображение интерфейса подложка c-Si/естественный окисел. b — ВРПЭМ-изображение отдельной НЧ Аи в матрице a-SiO<sub>1.8</sub>.

мого нестехиометрического оксида кремния (рис. 2, b). Спектры содержат характерные для *a*-SiO<sub>x</sub> синфазные (центр на  $1052 - 1055 \,\mathrm{cm}^{-1}$ ) и противофазные (центр на  $\sim 1140\,{\rm cm}^{-1})$  моды колебания растяжения группы Si-O-Si. Согласно положению центра синфазной моды, стехиометрический коэффициент *a*-SiO<sub>x</sub> составил  $1.8 \pm 0.2$  [11], что хорошо согласуется с результатами, полученными другими методами (энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, эллипсометрии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии).

Анализ поперечного среза образца методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), выполненный на микроскопе JEOL JEM-2200FS, позволил получить более детальное представление о его морфологии (рис. 3, a), поскольку хорошо известно, что несферичность НЧ металлов оказывает влияние на их оптические характеристики [9]. Средний размер НЧ Аи составил ~ 10 nm, что в совокупности с данными СЭМ (12 nm) позволяет сделать вывод о сферической форме НЧ. Также из снимка видно, что покрытие НЧ Аи тонкой пленкой *a*-SiO<sub>1.8</sub> равномерное, и это позволяет считать его сплошным при анализе оптических свойств. Методом ПЭМ высокого разрешения (ВРПЭМ) была исследована структура материала. Данные (рис. 3, b) указывают на то, что пленка *a*-SiO<sub>1.8</sub> имеет аморфную структуру, в то время как НЧ содержат как аморфную, так и кристаллическую фазу. Такие частицы могут формироваться в результате коалесценции островков, образующихся в результате различных механизмов: зародыши кристаллических НЧ образуются в лазерном факеле, аморфных — в результате столкновения адатомов [12]. Известно, что наличие кристаллических граней может влиять на проводимость металла, а следовательно, частота колебания электронов проводимости, составляющих локализованный плазмон, может отличаться от данных, приводимых в литературе. Подобно тому как в [13] была введена поправка на частоту колебания электронов при столкновении с границей НЧ, необходимо также учитывать их рассеяние на границах раздела областей разных фаз и кристаллитов различной кристаллографической ориентации. Отметим, что, согласно ВРПЭМ-изображению (вставка к рис. 3, *a*), золото проникает под естественный окисел и образует аморфные эллипсоидные глобулы на границе его раздела с *c*-Si, что обусловлено взаиморастворимостью *c*-Si и Аи при высоких температурах [14]. Однако мы полагаем, что этот эффект отсутствует при осаждении НЧ Аи на кварцевую подложку при данной температуре синтеза.

В работе впервые проведено исследование морфологии, структурных и оптических свойств композитного материала на основе НЧ Аu и тонкой пленки *a*-SiO<sub>1.8</sub>. Сферичность формы НЧ Аи подтверждена взаимодополняющими исследованиями, проведенными методами СЭМ и ПЭМ. ПЭМ-исследования показали конформность покрытия НЧ Au слоем a-SiO<sub>1.8</sub>. Классическая аналитическая модель на базе теории Ми хорошо описывает полученные из эксперимента оптические свойства НЧ Аи и композитного материала в УФ-области спектра, а также изменение амплитуды плазмонного пика при формировании композитного материала.

### Благодарности

Авторы благодарны Г.К. Кривякину за ПЭМ-исследования образцов.

#### Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 19-79-10143 (осаждение НЧ Аи и *a*-SiO<sub>x</sub>, анализ методами СЭМ и ПЭМ) и гранта Президента РФ МК-2404.2019.8 (исследование оптических свойств материалов, расчеты по теории Ми).

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986. 664 с.
- [2] Walters G., Parkin I.P. // J. Mater. Chem. 2009. V. 19. P. 574– 590. DOI: 10.1039/B809646E
- [3] Safonov A.I., Sulyaeva V.S., Timoshenko N.I., Kubrak K.V., Starinskiy S.V. // Phys. Lett. A. 2016. V. 380. P. 3919–3923.
   DOI: 10.1016/j.physleta.2016.10.003
- [4] Tinguely J.C., Sow I., Leiner C., Grand J., Hohenau A., Felidj N., Aubard J., Krenn J.R. // Bionanoscience. 2011. V. 1.
   P. 128–135. DOI: 10.1007/s12668-011-0015-4
- [5] de Aberasturi D.J., Serrano-Montes A.B., Liz-Marzán L.M. // Adv. Opt. Mater. 2015. V. 3. P. 602–617. DOI: 10.1002/adom.201500053
- [6] Rai M., Ingle A.P., Birla S., Yadav A., Dos Santos C.A. // Crit. Rev. Microbiol. 2015. V. 42. P. 696–719. DOI: 10.3109/1040841X.2015.1018131
- [7] Faraone G., Modi R., Marom S., Podestá A., Di Vece M. // Opt. Mater. 2018. V. 75. P. 204–210. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2017.10.025
- [8] Bedel L., Cayron C., Jouve M., Maury F. // Nanotechnology. 2012. V. 23. P. 015603. https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/1/015603
- [9] Davis T.J., Gómez D.E. // Rev. Mod. Phys. 2017. V. 89.
  P. 011003. DOI: 10.1103/RevModPhys.89.011003
- [10] Axelevitch A., Apter B., Golan G. // Opt. Express. 2013. V. 21.
  P. 4126–4138. DOI: 10.1364/OE.21.004126
- Zamchiy A.O., Baranov E.A., Merkulova I.E., Khmel S.Y., Maximovskiy E.A. // J. Non. Cryst. Solids. 2019. V. 518. P. 43– 50. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.05.015
- [12] Starinskiy S.V., Sulyaeva V.S., Shukhov Y.G., Cherkov A.G., Timoshenko N.I., Bulgakov A.V., Safonov A.I. // J. Struct. Chem. 2017. V. 58. P. 1581–1587. DOI: 10.26902/JSC20170815
- [13] Kreibig U, Fragstein C. // Z. Phys. 1969. V. 224. P. 307–323.
  DOI: 10.1007/BF01393059
- [14] Bhatta U.M., Dash J.K., Rath A., Satyam P.V. // Appl. Surf. Sci. 2009. V. 256. P. 567–571. DOI: 10.1016/j.apsusc.2009.08.054